

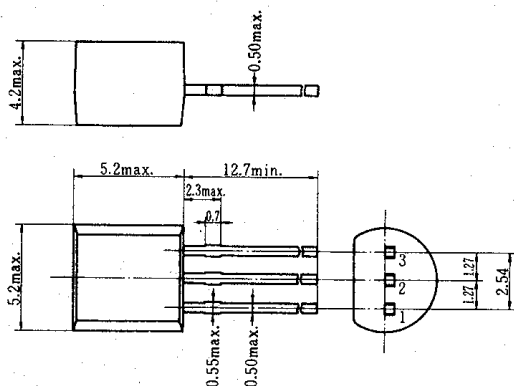
2SK54

シリコンNチャネル接合形FET

VHF高周波増幅, 混合用

SILICON N-CHANNEL JUNCTION FET

VHF AMPLIFIER, MIXER



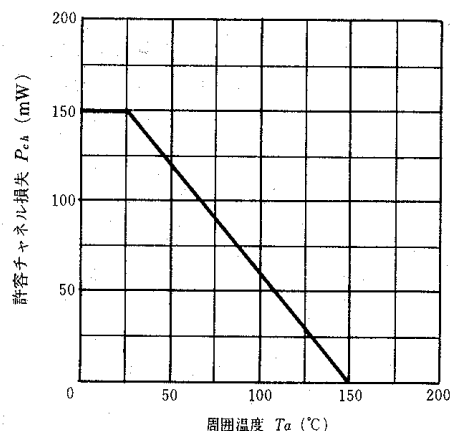
(JEDEC TO-92)

1. ゲート: Gate
 2. ソース: Source
 3. ドレイン: Drain
- (Dimensions in mm)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	2SK54	Unit
ゲート・ドレイン電圧	V_{GDO}	-15	V
ゲート電流	I_G	10	mA
許容チャネル損失	P_{ch}	150	mW
チャネル温度	T_{ch}	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

許容チャネル損失の周囲温度による変化 MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
ゲート・ドレイン破壊電圧	$V_{(BR)GDO}$	$I_G = -100\mu\text{A}$, $I_S = 0$	-15	—	—	V
ゲート遮断電流	I_{GSS}	$V_{GS} = -0.5\text{V}$, $V_{DS} = 0$	—	—	-10	nA
ドレイン電流	I_{DSS}^*	$V_{DS} = 10\text{V}$, $V_{GS} = 0$	0.8	—	5	mA
ゲート・ソース遮断電圧	$V_{GS(off)}$	$V_{DS} = 10\text{V}$, $I_D = 10\mu\text{A}$	-0.3	—	-5.5	V
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$V_{DS} = 10\text{V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1\text{kHz}$	3	6	—	mS
入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = 10\text{V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1\text{MHz}$	—	3	—	pF
逆伝達容量	C_{rss}	$V_{DS} = 10\text{V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1\text{MHz}$	—	0.4	0.6	pF
電力利得	PG	$V_{DD} = 10\text{V}$, $R_S = 33\Omega$, $f = 100\text{MHz}$	—	15	—	dB
雑音指数	NF		—	2.0	3.5	dB

*2SK54は I_{DSS} の値により下記のように2区分し、現品に表示してあります。

*The 2SK54 is grouped by I_{DSS} as follows.

B	C
0.8~2.4 mA	2~5 mA